



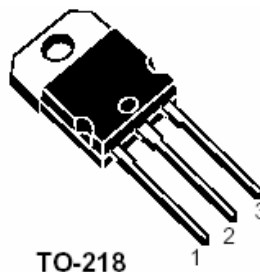
# ЗАО «ЭПЛ» ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

124482, Москва, Зеленоград, а/я 167, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (495) 532-81-95,  
тел.(495) 532-93-36. E-mail: [epl@epl.ru](mailto:epl@epl.ru), <http://www.epl.ru>

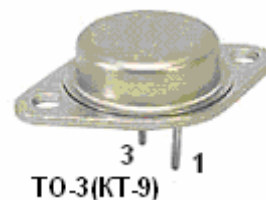
## Мощный MOSFET транзистор – КП7182А

Тип корпуса: TO-218, TO-3(КТ-9)

Аналоги: IXFH20N60



TO-218



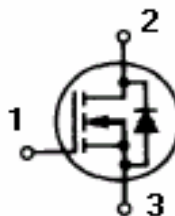
TO-3(КТ-9)

### Особенности

- N- канальный
- Низкий подзатворный заряд
- Низкое сопротивление  $R_{DS(on)}$
- Быстро переключающийся транзистор

### Область применения

- DC-DC преобразователи
- Импульсные источники питания
- Устройства зарядки аккумуляторов



$V_{DSS} = 600 \text{ В}$

$R_{DS(on)} \leq 350 \text{ м}\Omega$

$I_D = 20 \text{ А}$

1- затвор

2- сток

3- исток

### 1. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Параметры	Обозначение	Режимы измерения	Норма	Единица измерения
Напряжение сток-исток	$V_{DSS}$	$V_{GS}=0\text{В}, T_J=25^\circ\text{C}$	600	В
Напряжение затвор-исток	$V_{GSS}$	$V_{DS}=0\text{В}$	$\pm 20$	В
Постоянный ток стока	$I_D$	$V_{GS}=10\text{В}$	20	А
Импульсный ток стока	$I_{DM}$	$T_{имп} = 10\mu\text{s}$	80	А
Рассеиваемая мощность	$P_D$		300	Вт
Рабочая температура кристалла	$T_J$	-55÷+150		$^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды (допустимая)	$T_{JM}$	150		$^\circ\text{C}$
Температура хранения	$T_{STG}$	-55÷+125		$^\circ\text{C}$
Максимальная скорость нарастания напряжения на диоде	$dv/dt$	$I_S \leq I_{DM}, di/dt \leq 100\text{А}/\mu\text{s}, V_{DD} \leq V_{DSS}, T_J \leq 150^\circ\text{C}, R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
Масса: TO-218 TO-3			5,5 20	Гр.

«EPL» Semiconductor Devices Production.

124482, Moscow, Zelenograd, a/b 167. Tel./fax +7(495) 532-81-95, tel.+7(495) 532-93-36.  
<http://www.epl.ru>, E-mail: [epl@epl.ru](mailto:epl@epl.ru)



# ЗАО «ЭПЛ» ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

124482, Москва, Зеленоград, а/я 167, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (495) 532-81-95,  
тел.(495) 532-93-36. E-mail: [epl@epl.ru](mailto:epl@epl.ru), <http://www.epl.ru>

## 2. Основные электрические параметры

КП7182А

Параметры	Обозначение	Режимы измерения	Значения			Единица измерения
			мин.	тип.	макс	
Напряжения пробоя сток-исток	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ В}, I_D = 250 \mu\text{А}$	600	-	-	В
Пороговое напряжение затвор-исток	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = 20 \text{ В}, I_D = 4 \text{ мА}$	2,5	-	4,5	В
Начальный ток стока	$I_{DSS}$	$V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0 \text{ В}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	-	-	25	$\mu\text{А}$
Начальный ток стока	$I_{DSS}$	$V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0 \text{ В}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	-	-	1	мА
Ток утечки затвор-исток	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20 \text{ В}, V_{DS} = 0 \text{ В}$	-	-	$\pm 100$	нА
Сопротивление ключа в открытом состоянии.	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10 \text{ В}, I_D = 10 \text{ А}$ $t_{имп} \leq 300 \mu\text{с}, D \leq 2\%$	-	-	350	м $\Omega$
Входная емкость	$C_{ISS}$	$V_{GS} = 0 \text{ В}, V_{DS} = 25 \text{ В},$ $f = 1 \text{ МГц}$	-	3300	-	пФ
Выходная емкость	$C_{OSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ В}, V_{DS} = 25 \text{ В},$ $f = 1 \text{ МГц}$	-	420	-	пФ
Проходная емкость	$C_{RSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ В}, V_{DS} = 25 \text{ В},$ $f = 1 \text{ МГц}$	-	140	-	пФ
Время задержки на включения	$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ В}, V_{DS} = 300 \text{ В},$ $I_D = 10 \text{ А}, R_G = 2 \Omega$	-	20	40	нс
Время нарастания	$t_r$	$V_{GS} = 10 \text{ В}, V_{DS} = 300 \text{ В},$ $I_D = 10 \text{ А}, R_G = 2 \Omega$	-	43	60	нс
Время задержки выключения	$t_{d(off)}$	$V_{GS} = 10 \text{ В}, V_{DS} = 300 \text{ В},$ $I_D = 10 \text{ А}, R_G = 2 \Omega$	-	70	90	нс
Время спада	$t_f$	$V_{GS} = 10 \text{ В}, V_{DS} = 300 \text{ В},$ $I_D = 10 \text{ А}, R_G = 2 \Omega$	-	40	60	нс
Тепловое сопротивление кристалл-основание	$R_{thJC}$		-	-	0,42	К/Вт
Тепловое сопротивление основания	$R_{thJK}$	ТО-218, ТО-3(КТ-9)	-	0,25	-	К/Вт
Прямой ток диода	$I_S$	$V_{GS} = 0 \text{ В}, T_J = T_{JM}$	-	-	20	А
Прямое падение напряжения на диоде	$V_{SD}$	$I_F = I_S, V_{GS} = 0 \text{ В},$ $t_{имп} \leq 300 \mu\text{с}, D \leq 2\%$	-	-	1,5	В
Время обратного восстановления	$t_{rr}$	$I_F = I_S, di/dt = 100 \text{ А}/\mu\text{с},$ $V_R = 100 \text{ В}, T_J = 25^\circ\text{C}$	-	-	250	нс

**«EPL» Semiconductor Devices Production.**

124482, Moscow, Zelenograd, a/b 167. Tel./fax +7(495) 532-81-95, tel.+7(495) 532-93-36.  
<http://www.epl.ru>, E-mail: [epl@epl.ru](mailto:epl@epl.ru)